

2SC2833, 2SC2833A

シリコン NPN 三重拡散メサ形 / Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

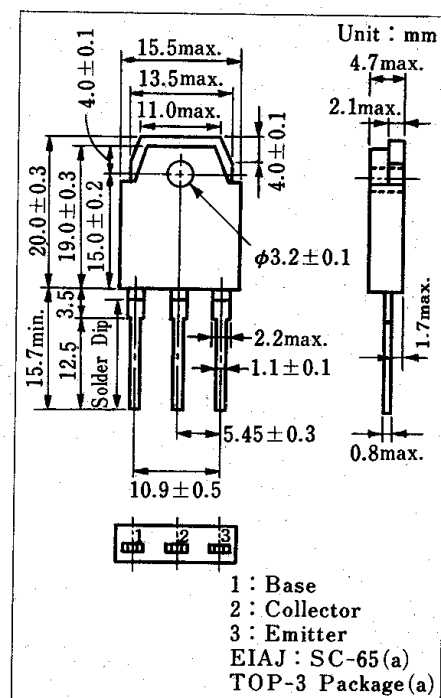
高速スイッチング用 / High Speed Switching

■ 特徴 / Features

- スwitching速度が速い。 / High speed switching
- コレクタ・ベース電圧 V_{CB0} が高い。 / High V_{CB0}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	800	V
		900	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	8	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	10	A
コレクタ電流	I_C	5	A
ベース電流	I_B	3	A
コレクタ損失	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_C	W
	$T_a = 25^\circ\text{C}$	P_C	
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	2SC2833	I _{CBO}	V _{CB} =800 V, I _E =0			100	μA
	2SC2833A		V _{CB} =900 V, I _E =0			100	
エミッタしゃ断電流		I _{EBO}	V _{EB} =5 V, I _C =0			100	μA
コレクタ・エミッタ電圧		V _{CEO(sus)}	I _C =0.2 A, L=25 mH	500			V
直流電流増幅率		h _{FE1}	V _{CE} =5 V, I _C =0.1 A	15			
		h _{FE2}	V _{CE} =5 V, I _C =3 A	8			
コレクタ・エミッタ飽和電圧		V _{CE(sat)}	I _C =3 A, I _B =0.6 A			1	V
ベース・エミッタ飽和電圧		V _{BE(sat)}	I _C =3 A, I _B =0.6 A			1.5	V
トランジション周波数		f _T	V _{CE} =10 V, I _C =0.5 A		3		MHz
ターンオン時間	2SC2833	t _{on}	I _C =3 A I _{B1} =0.6 A, I _{B2} =-0.6 A V _{CC} =200 V			1	μs
	2SC2833A					1.2	
蓄積時間		t _{stg}				3	μs
下降時間	2SC2833	t _f				1	μs
	2SC2833A					1.2	